

ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Том **41**, выпуск **19**, 12 октября **2015**



С.-Петербург
«НАУКА»

<http://www.ioffe.ru/journals/pjtf/>

Содержание

**Еуров Д.А., Грудинкин С.А., Курдюков Д.А., Медведев А.В., Стов-
пига Е.Ю., Голубев В.Г.**

Безактиваторные люминесцентные наноконтейнеры для тераностики рако-
вых опухолей 1

**Конюшенко М.А., Филатова Е.О., Конашук А.С., Нелюбов А.В.,
Шулаков А.С.**

Экспериментальное определение положения потолка валентной зоны в α -
 Al_2O_3 и γ - Al_2O_3 8

Мачихин А.С., Польщикова О.В., Рамазанова А.Г., Пожар В.Э.

Регистрация цифровых голограмм оптически прозрачных объектов в произ-
вольных спектральных интервалах на основе акустооптической фильтрации
излучения 16

**Пронин И.А., Аверин И.А., Божинова А.С., Георгиева А.Ц., Ди-
митров Д.Ц., Карманов А.А., Мошников В.А., Папазова К.И.,
Теруков Е.И., Якушова Н.Д.**

Термовольтаический эффект в оксиде цинка, неоднородно легированном
примесями с переменной валентностью 22

Поливанов П.А., Сидоренко А.А., Маслов А.А.

Влияние ламинарно-турбулентного перехода на взаимодействие ударной
волны с пограничным слоем при малом сверхзвуковом числе Маха 29

Ветлужский А.Ю., Ломухин Ю.Л.

Собственные волны многопроводной среды 38

**Макаревич А.В., Шепелевич В.В., Ропот П.И., Навныко В.Н.,
Шандаров С.М.**

Экспериментальное исследование ориентационной зависимости дифракци-
онной эффективности пропускающих голограмм от толщины кристалла
 $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ 46

Кощеев В.П., Штанов Ю.Н., Моргун Д.А., Панина Т.А.

Моделирование процесса отклонения релятивистских электронов изогнутым кристаллом кремния 55

Антонова И.В., Котин И.А., Небогатикова Н.А., Принц В.Я.

Самоформирующиеся латеральные гетероструктуры на основе графена с возможностью модуляции тока на 4–5 порядков 64

Хрыкин О.И., Дроздов Ю.Н., Дроздов М.Н., Юнин П.А., Шашкин В.И., Богданов С.А., Мучников А.Б., Вихарев А.Л., Радищев Д.Б.

Монокристаллические слои GaN/AlN на CVD-алмазе 73

Белов А.И., Михайлов А.Н., Королев Д.С., Сергеев В.А., Окулич Е.В., Антонов И.Н., Касаткин А.П., Грязнов Е.Г., Ятманов А.П., Горшков О.Н., Тетельбаум Д.И.

Влияние облучения ионами H^+ и Ne^+ на резистивное переключение в мемристивных структурах „металл–диэлектрик–металл“ на основе SiO_x 81

Куликов Д.В., Лубов М.Н., Трушин Ю.В., Харламов В.С.

Кинетическое моделирование роста кластеров меди различной высоты в подповерхностных слоях свинца 90

Бобашев С.В., Жуков Б.Г., Куракин Р.О., Поняев С.А., Резников Б.И.

Влияние материала электродов на движение плазменного поршня в рельсовых ускорителях 96

Сарафанов Г.Ф., Перевезенцев В.Н.

Критерий зарождения микротрещины в упругом поле дисклинации, экранированном ансамблем дислокаций 105